

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIERE,  
INSTITUT RAYONNEMENT MATIÈRE DE SACLAY

SERVICE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES SURFACES ET DES INTERFACES

# SEMINAIRE \*

Mardi 20 mai 2008 à 11h00

Bâtiment 466, salle 111 - CEA Saclay, 91191, Gif sur Yvette

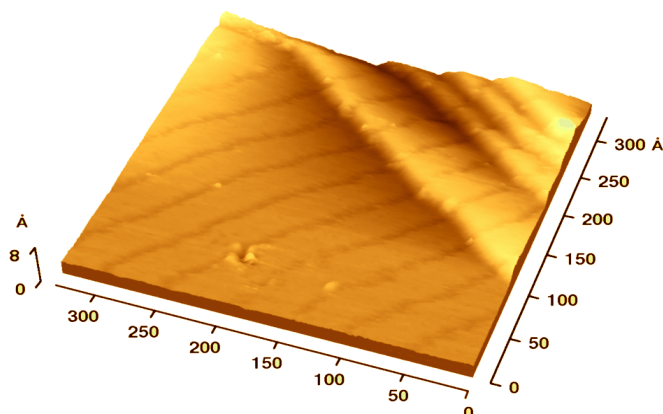
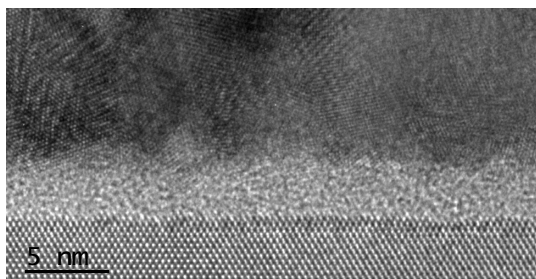
## Growth and oxidation of Al thin films deposited on Ag(111) and Si(100)-H

Sebastien Vizzini

CINAM - CNRS, Campus de Luminy, Marseille

*Invité par Patrick Soukiassian*

Résumé : Using different techniques of investigation (AES, LEED, STM, HR-TEM, EELS and PES), we have developed an original process, which consists to grow aluminium oxide layer by layer. This procedure so-called Atomic Layer Deposition and Oxidation (ALDO) allows to get an artificial oxide film perfectly homogeneous in depth and chemical composition as well. Several properties like gap measurement, stoichiometry, surface morphology and electrons transport let us think this oxide could be in good agreement with microelectronics applications (Magnetic Tunnel Junction and Magnetic memories).



\* SERA PRECEDE D'UNE PAUSE-CAFE A PARTIR DE 10H30

*Formalités d'entrée : Contacter le secrétariat pour l'établissement de votre autorisation d'entrée sur le centre de Saclay. Tel : 01.69.08.65.32 ou 01.69.08.40.12; Fax : 01.69.08.40.44 ; e-mail : catherine.julien@cea.fr. Le délai minimum est de 24 heures pour les visiteurs ressortissants des pays de l'Union Européenne, et de huit jours pour les autres. Sans autorisation, vous ne pourrez entrer sur le centre de Saclay. Dans tous les cas, se munir d'une pièce d'identité.*